



## 【1000～2000万円】 Power Device Design Senior Engineer

外資系デバイスメーカーでの募集です。電子デバイス研究開発のご経験のある方は歓迎...

### Job Information

**Recruiter**

JAC Recruitment Co., Ltd.

**Hiring Company**

外資系デバイスメーカー

**Job ID**

1586991

**Industry**

Communication

**Company Type**

International Company

**Job Type**

Permanent Full-time

**Location**

Osaka Prefecture

**Salary**

10 million yen ~ 20 million yen

**Work Hours**

09:00 ~ 18:00

**Holidays**

詳細は求人ご紹介時にご案内いたします。

**Refreshed**

May 2nd, 2026 14:00

### General Requirements

**Career Level**

Mid Career

**Minimum English Level**

Business Level

**Minimum Japanese Level**

Native

**Minimum Education Level**

Bachelor's Degree

**Visa Status**

Permission to work in Japan required

### Job Description

【求人No NJB2224778】

- ・高性能パワーデバイス (SiC MOSFET/SBD, GaN HEMT, Si IGBT) のデザイン開発とテスト検証を担当し、プロセスチームと協力してデバイス加工とプロセスの最適化を行う。
- ・高性能パワーデバイス (SiC MOSFET/SBD, GaN HEMT, Si IGBT) の個別技術をフォローアップし、既存のデバイスの性能を向上させ、パテントポートフォリオを提案して実現させる。

## Required Skills

### 必須要件

- ・半導体/電子/物理などの関連分野を専攻し、5年以上のパワーデバイスのデザイン開発経験（直近の3年間には関連のデザイン開発の従事が必須）、または優秀な博士課程の新卒者。
  - ・パワーデバイス（SiC MOSFET/SBD、GaN HEMT、Si IGBT）の基本構造とデバイスシミュレーションデザイン方法に精通し、TCADソフトやレイアウトソフトを使用しデバイスデザインが得意な方。
  - ・良好なコミュニケーション能力があり、異なる地域や異なる文化背景のチームと良好なコミュニケーションがとれる方。
- 

## Company Description

ご紹介時にご案内いたします